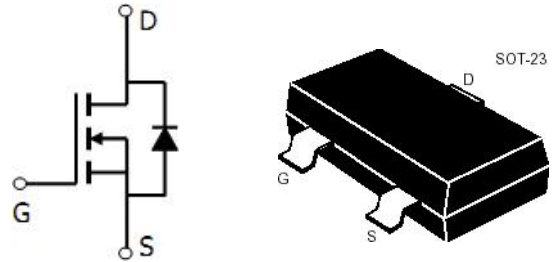


## FS3400M

SOT-23 場效應晶體管(SOT-23 Field Effect Transistors)



### N-Channel Enhancement-Mode MOS FETs

N 沟道增强型 MOS 场效应管

#### ■ MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓	$BV_{DSS}$	30	V
Gate- Source Voltage 柵極-源極電壓	$V_{GS}$	$\pm 12$	V
Drain Current (continuous) 漏極電流-連續	$I_D$	5.8	A
Drain Current (pulsed) 漏極電流-脈沖	$I_{DM}$	18	A
Total Device Dissipation 總耗散功率 $T_A=25^\circ\text{C}$ 環境溫度為 $25^\circ\text{C}$	PD	1400	mW
Junction 結溫	$T_J$	150	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature 儲存溫度	$T_{stg}$	-55to+150	$^\circ\text{C}$

#### ■ DEVICE MARKING 打標

**FS3400M=A09T**



## FS3400M

### ■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

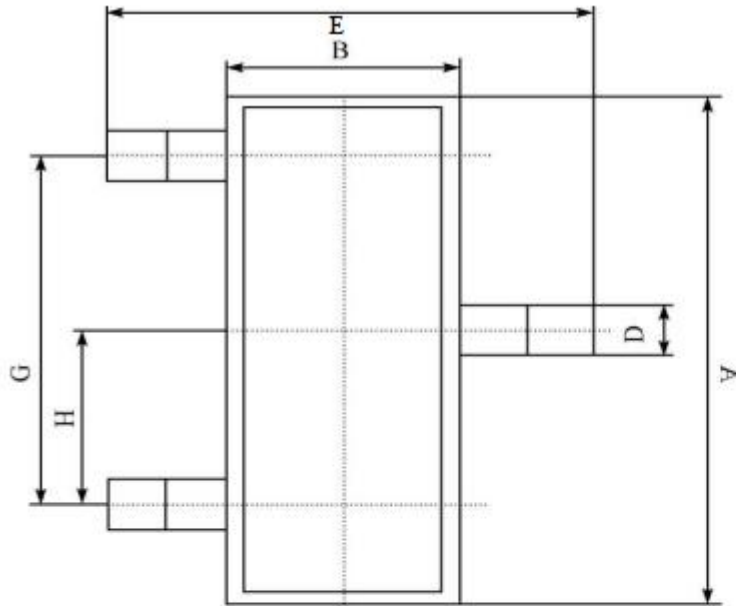
( $T_A=25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise noted 如無特殊說明, 溫度為  $25^{\circ}\text{C}$ )

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓( $I_D=250\mu\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$ )	$BV_{DSS}$	30	—	—	V
Gate Threshold Voltage 柵極開啓電壓( $I_D=250\mu\text{A}, V_{GS}=V_{DS}$ )	$V_{GS(th)}$	0.6	—	2	V
Diode Forward Voltage Drop 內附二極管正向壓降( $I_S=1.25\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$ )	$V_{SD}$	—	0.7	1	V
Zero Gate Voltage Drain Current 零柵壓漏極電流( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=30\text{V}$ )	$I_{DSS}$	—	—	1	$\mu\text{A}$
Gate Body Leakage 柵極漏電流( $V_{GS}=\pm 12\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$ )	$I_{GSS}$	—	—	$\pm 100$	nA
Static Drain-Source On-State Resistance 靜態漏源導通電阻( $I_D=5\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$ )	$R_{DS(on)}$	—	32	38	$\text{m}\Omega$
Static Drain-Source On-State Resistance 靜態漏源導通電阻( $I_D=3.5\text{A}, V_{GS}=4.5\text{V}$ )	$R_{DS(on)}$	—	40	45	$\text{m}\Omega$
Static Drain-Source On-State Resistance 靜態漏源導通電阻( $I_D=3\text{A}, V_{GS}=2.5\text{V}$ )	$R_{DS(on)}$	—	50	55	$\text{m}\Omega$
Input Capacitance 輸入電容 ( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=15\text{V}, f=1\text{MHz}$ )	$C_{ISS}$	—	545	—	pF
Output Capacitance 輸出電容 ( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=15\text{V}, f=1\text{MHz}$ )	$C_{OSS}$	—	66	—	pF
Turn-ON Time 開啓時間 ( $V_{DS}=15\text{V}, V_{GS}=10\text{V}, R_{GEN}=6\Omega$ )	$t_{(on)}$	—	9.6	—	ns
Turn-OFF Time 關斷時間 ( $V_{DS}=15\text{V}, V_{GS}=10\text{V}, R_{GEN}=6\Omega$ )	$t_{(off)}$	—	39	—	ns

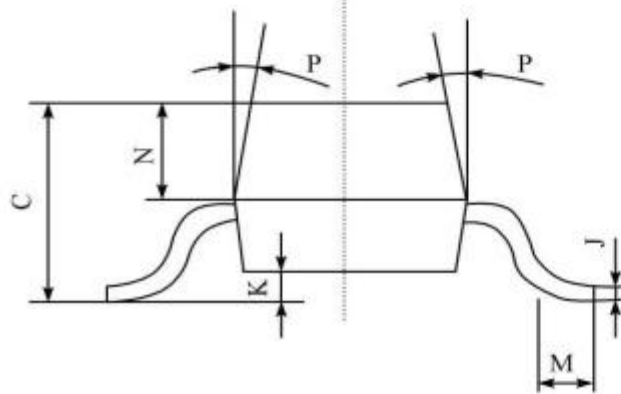
Pulse Width $\leq 300\mu\text{s}$ ; Duty Cycle $\leq 2.0\%$

## FS3400M

■ **DIMENSION** 外形封裝尺寸  
單位(UNIT): mm



代碼	範圍(單位:mm)
A	2.80~3.00
B	1.20~1.40
C	0.90~1.10
D	0.30~0.50
E	2.20~2.60
G	1.80~2.00
H	0.90~1.00
J	0.08~0.18
K	0.02~0.12
M	≥0.22
N	0.50~0.70
P	6°~10°



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [MOSFET](#) category:*

*Click to view products by [FOSAN](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[614233C](#) [648584F](#) [IRFD120](#) [IRFF430](#) [JANTX2N5237](#) [2N7000](#) [FCA20N60\\_F109](#) [FDZ595PZ](#) [AOD464](#) [2SK2267\(Q\)](#) [2SK2545\(Q,T\)](#)  
[405094E](#) [423220D](#) [MIC4420CM-TR](#) [VN1206L](#) [614234A](#) [715780A](#) [SSM6J414TU,LF\(T](#) [751625C](#) [PSMN4R2-30MLD](#)  
[TK31J60W5,S1VQ\(O](#) [2SK2614\(TE16L1,Q\)](#) [DMN1017UCP3-7](#) [EFC2J004NUZTDG](#) [FCAB21350L1](#) [P85W28HP2F-7071](#) [DMN1053UCP4-7](#)  
[NTE2384](#) [NTE2969](#) [NTE6400A](#) [DMN2080UCB4-7](#) [DMN61D9UWQ-13](#) [US6M2GTR](#) [DMN31D5UDJ-7](#) [SSM6P54TU,LF](#) [DMP22D4UFO-](#)  
[7B](#) [IPS60R3K4CEAKMA1](#) [DMN1006UCA6-7](#) [DMN16M9UCA6-7](#) [STF5N65M6](#) [STU5N65M6](#) [C3M0021120D](#) [DMN13M9UCA6-7](#)  
[BSS340NWH6327XTSA1](#) [MCM3400A-TP](#) [DMTH10H4M6SPS-13](#) [IRF40SC240ARMA1](#) [IPS60R1K0PFD7SAKMA1](#)  
[IPS60R360PFD7SAKMA1](#) [IPS60R600PFD7SAKMA1](#)